

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 7 部門第 2 区分

【発行日】平成 21 年 7 月 30 日 (2009.7.30)

【公開番号】特開 2007-43118 (P2007-43118A)

【公開日】平成 19 年 2 月 15 日 (2007.2.15)

【年通号数】公開・登録公報 2007-006

【出願番号】特願 2006-179052 (P2006-179052)

【国際特許分類】

H 0 5 K 3/20 (2006.01)

H 0 5 K 3/28 (2006.01)

H 0 1 L 21/336 (2006.01)

H 0 1 L 29/786 (2006.01)

H 0 1 L 21/3205 (2006.01)

【F I】

H 0 5 K 3/20 B

H 0 5 K 3/28 F

H 0 1 L 29/78 6 2 7 D

H 0 1 L 21/88 B

【手続補正書】

【提出日】平成 21 年 6 月 12 日 (2009.6.12)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

基板上に設けられた導電性を示すパターン上に、電解めっき処理により導電膜を形成し、
 前記導電膜に基体を貼り付け、
前記基体を前記基板から剥がすことにより、前記パターンと前記導電膜とを分離すること
 を特徴とする配線基板の作製方法。

【請求項 2】

基板上に設けられた導電性を示すパターン上に、電解めっき処理により導電膜を形成し、
 前記電解めっき処理の後、前記基板を洗浄し、
 前記導電膜に基体を貼り付け、
 前記基体を前記基板から剥がすことにより、前記パターンと前記導電膜とを分離すること
 を特徴とする配線基板の作製方法。

【請求項 3】

請求項 1 又は請求項 2 において、
 前記パターンは、Fe、Al、Cu、Ag、Ni、W、Ti、Mg、Nb、又は Sn を
 含むことを特徴とする配線基板の作製方法。

【請求項 4】

請求項 1 乃至請求項 3 のいずれか一項において、
 前記導電膜は、Ag と Au との合金、Cu と Au との合金、Ni と Au との合金、Cd
 と Au との合金、Co と Au との合金、Cu、Ni、Sn、Pb、Cr、Au、Ag、Rh、Co、又は Cd を含むことを特徴とする配線基板の作製方法。

【請求項 5】

第 1 の基板上に設けられた導電性を示すパターン上に、電解めっき処理により導電膜を形成し、

前記導電膜に基体を貼り付け、

前記基体を前記基板から剥がすことにより、前記パターンと前記導電膜とを分離し、

前記導電膜と、第 2 の基板上に設けられ少なくとも 1 つの薄膜トランジスタを有する IC チップとを、電氣的に接続することを特徴とする半導体装置の作製方法。

【請求項 6】

第 1 の基板上に設けられた導電性を示すパターン上に、電解めっき処理により導電膜を形成し、

前記導電膜に基体を貼り付け、

前記基体を前記基板から剥がすことにより、前記パターンと前記導電膜とを分離し、

第 2 の基板上に設けられ少なくとも 1 つの薄膜トランジスタを有する IC チップ上に、導電性樹脂を形成し、

前記導電性樹脂を介して、前記導電膜と前記 IC チップとを電氣的に接続することを特徴とする半導体装置の作製方法。

【請求項 7】

第 1 の基板上に設けられた導電性を示すパターン上に、電解めっき処理により導電膜を形成し、

前記導電膜に基体を貼り付け、

前記基体を前記基板から剥がすことにより、前記パターンと前記導電膜とを分離し、

前記導電膜と、第 2 の基板上に設けられ少なくとも 1 つの薄膜トランジスタを有する IC チップとを、電氣的に接続し、

前記 IC チップと前記導電膜とを第 3 の基板で覆うことを特徴とする半導体装置の作製方法。

【請求項 8】

請求項 7 において、

前記第 3 の基板は、ポリプロピレン、ポリエステル、ビニル、ポリフッ化ビニル、塩化ビニル、繊維質な材料からなる紙、又は帯電防止フィルムを含むことを特徴とする半導体装置の作製方法。

【請求項 9】

請求項 7 において、

前記第 3 の基材は、基材フィルムと合成樹脂フィルムとの積層フィルムを含むことを特徴とする半導体装置の作製方法。

【請求項 10】

請求項 9 において、

前記基材フィルムは、ポリエステル、ポリアミド、無機蒸着フィルム、又は紙類であることを特徴とする半導体装置の作製方法。

【請求項 11】

請求項 9 又は請求項 10 において、

前記合成樹脂フィルムは、アクリル系合成樹脂又はエポキシ系合成樹脂であることを特徴とする半導体装置の作製方法。

【請求項 12】

請求項 5 乃至請求項 11 のいずれか一項において、

前記パターンは、Fe、Al、Cu、Ag、Ni、W、Ti、Mg、Nb、又はSnを含むことを特徴とする半導体装置の作製方法。

【請求項 13】

請求項 5 乃至請求項 12 のいずれか一項において、

前記導電膜は、Ag と Au との合金、Cu と Au との合金、Ni と Au との合金、Cd と Au との合金、Co と Au との合金、Cu、Ni、Sn、Pb、Cr、Au、Ag、R

h、C o、又はC dを含むことを特徴とする半導体装置の作製方法。